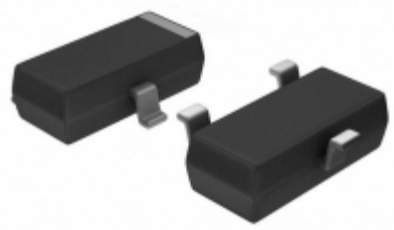

	<p>FDN359AN</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDN359AN</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 2.7A SSOT-3</p>
	<p>Datenblätter: 1.FDN359AN.pdf 2.FDN359AN.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
<p>Lagerzustand: New original, 149363 pcs Stock Available.</p>	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	FDN359AN
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 2.7A SSOT-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	149363 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	42 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 2.7A (Ta) 500mW (Ta) Surface Mount
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT-3
Verlustleistung (max)	500mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.7A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	46 mOhm @ 2.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	480pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDN359AN_F095

FDN359AN ist neu im Original, Suche FDN359AN Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDN359AN AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDN359AN: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDN358P Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 1.5A SSOT3</p>	 <p>FDN359BN-NL GC FDN359BN-NL GC</p>	 <p>FDN358P-NL FAIRCHI FDN358P-NL FAIRCHI</p>	 <p>FDN359AN Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 2.7A SSOT-3</p>
 <p>FDN359BN Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 2.7A 3SSOT</p>	 <p>FDN359BN FDK America MOSFET N-CH 30V 2.7A 3SSOT</p>	 <p>FDN358P_NL FAIRCHILD FAIRCHILD SOT23-3</p>	 <p>FDN358P AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 1.5A SSOT3</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ FDN336P-NL	↔ FDN336P-NL	⇒ FDN336P_NL	D FDN337N-NL	↔ FDN337N-NL/337
⊣ FDN338P-NL	⚙ FDN338P-NL/338	D FDN339AN	⇒ FDN339AN	↔ FDN339AN-NL
⚙ FDN339N-NL	⊣ FDN340P-NL	⚙ FDN342P-NL	↔ FDN352AP	↔ FDN352AP
D FDN352AP-NL	⚙ FDN352P-NL	⊣ FDN355A-NL	⚙ FDN355N-NL	↔ FDN356AP-NL
⇒ FDN356P-NL	↔ FDN357N-NL	⚙ FDN357NNL	⊣ FDN357P-NL	↔ FDN358P-NL
↔ FDN359AN	⇒ FDN359AN-NL	D FDN359BN	⚙ FDN359BN	⊣ FDN359BN
⚙ FDN359BN-NL	D FDN359N-NL	⇒ FDN360P-NL	↔ FDN360P-NL/360	↔ FDN361AN
⊣ FDN361AN	⚙ FDN361AN-NL	↔ FDN361BN	⇒ FDN361BN	↔ FDN361BN-NL
⚙ FDN362AN-NL	⊣ FDN363N-NL	⚙ FDN371N-NL	D FDN372S-NL	↔ FDN5330SX
↔ FDN537N-NL	⚙ FDN5618P	⊣ FDN5618P	⚙ FDN5618P-NL	↔ FDN5630-NL

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

